

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-7467

(P2003-7467A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
H05B 33/14	-	H 0 5 B 33/14	B 3K007
C09K 11/06	6 6 0	C 0 9 K 11/06	6 6 0
	690		6 9 0
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	В
			D
		審査請求 未請求	請求項の数10 OL (全 14 頁)
(21)出願番号	特願2001-184995(P2001-184995)	(71)出願人 0000053	26
		本田技	肝工業株式会社
(22)出顧日	平成13年6月19日(2001.6.19)	東京都洋	医南青山二丁目1番1号
		(72)発明者 柘植 稂	恵高
		埼玉県教	火山市新狭山1丁目10番地1 ホン
		ダエンシ	<sup>2</sup> ニアリング株式会社内
		(72)発明者 小松崎	明広
		埼玉県教	火山市新狭山1丁目10番地1 ホン
		ダエンシ	<b>アニアリング株式会社内</b>
		(74)代理人 10006002	25
		弁理士	北村 欣一 (外1名)
		F ターム(参考) 3K00	07 AB02 AB04 AB06 CA01 CB01
			DA01 DB03 EB00

## (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス案子

## (57)【要約】

(修正有)

【課題】高輝度の発光を可能にして、高い発光効率を有する有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】陽極層及び陰極層の両電極層間に形成され、ホスト剤と燐光を放射するドープ剤とを有する発光層を具備する有機エレクトロルミネッセンス素子において、ホスト剤として、



式1で表されるオキサジアゾール基、または、



式2で表されるトリアゾール基を有する電子輸送性物質 と、



(3)

式3で表されるカルバゾリル基を有する正孔輸送性物質 とを用いてバイポーラ性を具備させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極層及び陰極層の両電極層間に形成され、ホスト剤と燐光を放射するドープ剤とを有する発光層を具備する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記ホスト剤がバイポーラ性を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】前記パイポーラ性を有するホスト剤が、正 孔輸送性物質と電子輸送性物質とから成ることを特徴と する請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【請求項3】前記ホスト剤に用いる電子輸送性物質は、 【化1】

構造式 [化1] で表されるオキサジアゾール基を有する 化合物から成ることを特徴とする請求項2に記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】前記オキサジアゾール基を有する化合物 は、

【化2】

【化3】

【化4】

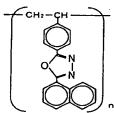
【化5】

【化6】

(2) 特開2003-7467 (P2003-7467A)

【化8】

10



構造式 [化2] 乃至 [化8] で表される化合物のうちー 種類以上から成ることを特徴とする請求項3に記載の有 機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】前記ホスト剤に用いる電子輸送性物質は、 【化9】

20 構造式 [化9] で表されるトリアゾール基を有する化合物から成ることを特徴とする請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】前記トリアゾール基を有する化合物は、 【化10】

【化11】

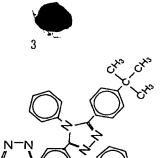
30

40

【化12】

【化13】

【化14】



$$\begin{pmatrix} N-N \\ N \\ X_5 \end{pmatrix}_n$$

(一般式 [化 16] 中、 $X_5$ は、水素、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複素環基のいずれかから、 $X_5$ は、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複素環基のいずれかから、それぞれ独立に選ばれる。)

【化17】

(一般式 [化17] 中、 $X_7$ は、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複素環基のいずれかから、 $X_8$ 及び $X_9$ は、水素、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複素環基のいずれかから、それ 40 ぞれ独立に選ばれる。)

【化18】

(一般式 [化18] 中、X10及びX11は、それぞれ独立 に水累、脂肪族炭化水聚基、芳香族炭化水聚基、エーテ ル基、複聚環基のいずれかから選ばれる。) (3) 特開2003-7467 (P2003-7467A)

満満式 [化10] 乃至 [化15]、または、一般式 [化16] 乃至 [化18] で表される化合物のうち一種類以上から成ることを特徴とする請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】前記ホスト剤に用いる正孔輸送性物質は、 【化19】

10 構造式 [化19] で表されるカルバソリル基を有する化合物から成ることを特徴とする請求項2乃至6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】前記カルパゾリル基を有する化合物は、 【化20】

【化 2 2 】 CH=CH₂

[化23]

[ft 2 4]

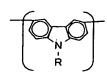
2-0-0-13

[化25]

【化26】

20

30



(一般式[化26]中のRは、それぞれ独立に、水素、 脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複 素環基のいずれかを示す。)

構造式 [化20] 乃至 [化25]、または、一般式 [化26]で表される化合物のうち一種類以上から成ること 50 を特徴とする請求項7に記載の有機エレクトロルミネッ



センス素子。

【請求項9】前記ドープ剤は、

【化27】

$$\left(\begin{array}{c} X_{12} \\ I \\ ArN \end{array}\right)_{n} I_{n} \left(X_{13}\right)_{3-n}$$

(一般式 [化 2 7] 中、Arはアリール基、X<sub>12</sub>及びX 13はそれぞれ独立に脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素 基、エーテル基、複素環基のいずれかを示し、ArとX 10 12とにおいて芳香環が縮合しても良く、 nは 1以上 3以 下の整数である。)

一般式 [化27] で表される化合物から成ることを特徴 とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の有機エレ クトロルミネッセンス素子。

【請求項10】前記ドープ剤の分子構造は、

【化28】

(一般式[化28]中、R1~R8は、それぞれ独立 に、水素、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エー テル基、複素環基のいずれかを示し、あるいは/および 隣接するRn (nは1以上8以下のいずれかから成る整 数)において芳香環が縮合しても良い。)

一般式[化28]で表される化合物から成ることを特徴 30 とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の有機エレ クトロルミネッセンス素子。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高輝度での発光が 可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、米国特許第6097147号によ り、燐光を放射する物質を含有する発光層を備えた多層 積層構造で形成された有機エレクトロルミネッセンス素 40 子が知られている。

【0003】このものでは、励起一重項状態による発 光、即ち、蛍光のみを利用して発光させる場合の内部母 子効率の理論的限界が25%であるのに対し、燐光によ る発光は、三重項状態の励起エネルギーが発光に寄与す るため内部量子効率の理論的限界を100%と考えてよ い。このため、駆動電圧に対する発光輝度で定義される 発光効率の向上が期待できる。

【0004】ところで、上記従来例の実施の態様では、 発光層中のホスト剤として、[化24]に示すカルバゾ 50 ール基を有する化合物から成ることが好適である。

67 (P2003-7467A)

ールビフェニル(以下CBPともいう。)を用い、ま た、発光層中のドープ剤として、

[0005] 【化29】

【0006】[化29]に示す2,3,7,8,12, 13,17,18-オクタエチル-21H,23H-白 金(II)ポルフィン(以下PtOEPとも言う。)を用 い、ホスト剤たるCBPを励起子として作用させてドー プ剤たるPtOEPに燐光を放射させている。

【0007】ところが、上記CBPは、構造中に有する カルバゾリル基に起因して正孔移動性を有する。このた め、陽極層と陰極層の各電極層からそれぞれ注入される 正孔と電子とが再結合するときのエネルギーを受容して 20 励起子として挙動する際に、本来は発光層中に拡散すべ きホスト剤たるCBPが、発光層中の陰極層側に偏在す ることになる。これに伴い、発光領域も発光層に隣接す る陰極層側の薄膜層(正孔ブロック層や電子輸送層な ど)との界面部分に集中し、発光輝度が充分に得られな いことがある。このような不具合は、有機エレクトロル ミネッセンス素子の駆動電圧が高くなると特に顕著とな り、量子効率の低下として示される。そして、これが所 期の発光効率の向上を阻害する要因になる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 に鑑み、高輝度の発光を可能にして、高い発光効率を有 する有機エレクトロルミネッセンス素子を提供すること を課題としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明は、陽極層及び陰極層の両電極層間に形成さ れ、ホスト剤と燐光を放射するドープ剤とを有する発光 層を具備する有機エレクトロルミネッセンス素子におい て、前記ホスト剤が、バイポーラ性、即ち、ラジカルカ チオン化及びラジカルアニオン化の複極性を有するよう に構成する。このものは、正孔移動性と電子移動性との 両方を有するため、発光層中の特定界面側に集中せず、 発光輝度を向上することができる。

【0010】また、この場合、前記ホスト剤として、正 孔輸送性物質と電子輸送性物質とを用いれば、バイポー ラ性、即ち、ラジカルカチオン化及びラジカルアニオン 化し易い複極性をホスト剤に確実に具備できる。

【0011】さらに、この場合、ホスト剤に用いる電子 輸送性物質は、構造式[化1]で表されるオキサジアゾ

【0012】そして、上記[化1]で表されるオキサジ アゾール基を有する化合物としては、 [化2] に示す2 - (4-ビフェニリル) -5- (4-tert-ブチル フェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、(以下P BDともいう。)、[化3]に示す2,5-ビス(1-ナフチル)-1.3.4-オキサジアゾール(以下にB NDともいう。)、[化4]に示す2,5-ビス(4-ビフェニリル) -1,3,4-オキサジアゾール (以下 BBDともいう。)、[化5]に示す1,3,5-トリ  $(5-(4-tert-7+\nu)-1, 3, 4)$ -オキサジアゾール)フェニル(以下OXD-1ともい う。)、[化6]に示す1,3-ジ(5-(4-ter t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾー ル)フェニル(以下OXD-7ともいう。)、または、 [化7] 若しくは[化8] で表されるオキサジアゾール 系高分子化合物のうち一種類以上を用いることが可能で ある。

【0013】また、ホスト剤に用いる電子輸送性物質と して、構造式[化9]で表されるトリアゾール基を有す る化合物を用いることも好適である。

【0014】そして、上記[化9]で表されるトリアゾ ール基を有する化合物としては、 [化10] に示す3- $(4-E_{7}x=1)u - 5 - (4-tert-7)u$ エニル) -4-フェニル-1, 2, 4-トリアゾール (以下、TAZともいう。)、[化11]に示す3, 4,5-トリ(1-ナフチル)-1,2,4-トリアゾ ール、[化12]に示す3,5ージ(4ーピフェニリ  $\nu$ ) -4-フェニル-1, 2, 4-トリアゾール、[化 13] に示す4-(1-ナフチル) -3,5-ジフェニ -1-フェニルー1, 3, 4-トリアゾール) フェニル、[化15] に示す1, 3-ジ(5-(4-tert ープチルフェニル) -1-フェニル-1,3,4-トリ アゾール)フェニル、または、[化16]乃至[化1 8] の一般式で示されるトリアゾール系高分子化合物の うち一種類以上を用いることが可能である。

【0015】また、これらの電子輸送性物質に対して、 ホスト剤に用いる正孔輸送性物質として、構造式[化1 9]で表されるカルバゾリル基を有する化合物を用いる 40 ことが好適である。

【0016】そして、上記カルバゾリル基を有する化合 物として、[化20]で示すカルバゾール、[化21] で示すNメチルカルバゾール、「化22]で示すNビニ ルカルバゾール、 [化23] で示すNフェニルカルバゾ ール、 [化24] で示すCBP、 [化25] で示すポリ (N-ビニルカルバゾール) (以下PVKともい う。)、一般式[化26]で示されるポリカルバゾール 化合物のうち一種類以上を用いることが可能である。

【0017】また、上記のようにバイポーラ性を有する 50

ホスト剤に対して、燐光を放射するドープ剤として一般 式 [化27] または [化28] に示される化合物を用い ると、このようなドープ剤は、発光層中に拡散・分散さ れているホスト剤に励起されて燐光を放射するので、こ れらのホスト剤とドープ剤とを有する発光層を備える有 機エレクトロルミネッセンス素子では、発光領域が偏在 せずに高輝度の発光が得られる。

[0018]

20

30

【発明の実施の形態】図1は、発光効率の向上を目的と 10 して多層に積層された素子構造を有する有機エレクトロ ルミネッセンス素子の基本構造を示す。有機エレクトロ ルミネッセンス素子の素子構造は、図外の基板上に形成 された陽極層10に、正孔輸送層20、電子ブロック層 30、発光層40、正孔ブロック層50及び電子輸送層 60の各薄膜層が、陽極層10と陰極層70との両電極 層間で順次積層されて成る多層積層構造であり、発光層 40は、発光層ドープ剤41と発光層ホスト剤42とを 有して構成されている。

【0019】図1で示される素子構造において、陽極層 10は、例えばガラス基板のような透明絶縁性支持体に 形成された透明な導電性物質が用いられ、その材料とし ては、酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム(I TO) などの導電性酸化物、あるいは、金、銀、クロム などの金属、よう化銅、硫化銅などの無機導電性物質、 ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン等の導電 性ポリマーなどを用いることができる。

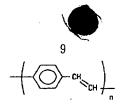
【0020】また、陰極層70が透明な材料で形成され ている場合には、陽極層10は不透明な材料で形成され ても良い。

【0021】また、図1で示される素子構造において、 陰極層70には、リチウム、ナトリウム、カリウム、ル ビジウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、スト ロンチウム、バリウム、硼素、アルミニウム、銅、銀、 金などの単体または合金が使用できる。さらに、これら を積層して使用することもできる。また、テトラヒドロ アルミン酸塩により湿式で形成することもできる。この 場合、陰極層70に用いられるテトラヒドロアルミン酸 塩としては、特に、水素化アルミニウムリチウム、水素 化アルミニウムカリウム、水素化アルミニウムマグネシ ウム、水素化アルミニウムカルシウムを挙げることがで きる。この中で、水素化アルミニウムリチウムが、特に 電子輸送層への電子注入性に優れている。

【0022】また、正孔輸送層20は、陽極層10から 注入される正孔を輸送するための層であり、正孔輸送性 有機物を含む有機層である。正孔輸送層性有機物の例と して、 [化25] で示すPVK、 [化26] で示すポリ カルバゾール化合物、

[0023]

【化30】



【0024】 [化30] に示すポリ (パラーフェニレンビニレン)、

[0025]

【化31】

【0026】[化31]で示されるN—フェニルポリカルバゾールなどの高分子からなることが好ましい。あるいは、[化20]で示すカルバゾール、[化21]で示す Nメチルカルバゾール、[化22]で示すNビニルカルバゾール、[化23]で示すNフェニルカルバゾール、[化24]で示すCBP、

[0027]

【化32】

【0028】 [化32] に示すN, N' -ジフェニル-N, N' -ビス(3-メチルフェニル) -1, 1' -ビフェニル-4, 4' -ジアミン(以下TPDともいう。)、

[0029]

【化33】

【0030】[化33]に示すN, N'ージフェニルーN, N'ービス(1ーナフチル)—1, 1'ービフェニルー4, 4'ージアミン(以下、NPDとも言う。) 【0031】

【化34】

【0032】 [化34] に示す4, 4'-ビス (10-フェノチアジニル) ビフェニル、

[0033]

【化35】

(6) 特開2003-1467 (P2003-7467A)

10

【0034】 [化35] に示すカッパーフタロシアニン 等が挙げられる。

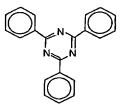
【0035】また、電子ブロック層30は、陰極層70 から発光層40へ注入された電子がそのまま陽極層10 へ通過してしまうことを防ぐため電子をブロックするための層であり、電子ブロック性物質で構成される。電子ブロック性物質としては、例えば、[化25]で示すPVK、[化30]で示されるポリ(パラーフェニレンビニレン)、[化24]で示されるCBP、[化32]で示されるTPD、[化33]で示されるNPD、[化34]で示される4,4'ービス(10-フェノチアジニル)ビフェニル、

[0036]

【化36】

20

30



【0037】[化36]に示す2,4,6-トリフェニル-1,3,5-トリアゾール、

[0038]

【化37】

【0039】[化37]に示すフローレン、などを挙げることができる。

【0040】また、発光層40はドープ剤41とホスト剤42とを有し、これらドープ剤41とホスト剤42とを均一に分散させるため、バインダ高分子を添加することも可能である。

【0041】ホスト剤42は、陽極層10及び陰極層70からそれぞれ注入された正孔と電子とが発光層40において再結合する際に賦活されて励起子として作用する物質であり、[化2]に示すPBD、[化3]に示すBND、[化4]に示すBBD、[化5]に示すOXD-1、[化6]に示すOXD-7、または、[化7]若しくは[化8]で表されるオキサジアゾール系高分子化合物、[化10]に示すTAZ、[化11]に示す3,4,5-トリ(1-ナフチル)-1,2,4-トリアゾール、[化12]に示す3,5-ジ(4-ビフェニリル)-4-フェニル-1,2,4-トリアゾール、[化13]に示す4-(1-ナフチル)-3,5-ジフェニ



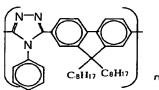
11

[0042]

【化38】

【0043】 【化39】

【0044】 【化40】



【0045】[化38] 乃至[化40] で示されるようなトリアゾール系高分子化合物、[化20] で示すカルバゾール、[化21] で示すNメチルカルバゾール、[化23]で示すNビニルカルバゾール、[化23]で示すNフェニルカルバゾール、[化24]で示すCBP、[化25]で示すポリ(Nービニルカルバゾール)(以下PVKともいう。)、一般式[化26]で示されるポリカルバゾール化合物などのカルバゾール系化合物、

[0046]

【化41】

【0047】(化学式[化41]中のRは、それぞれ独立 に脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、 (7) 特開2003-1467 (P2003-7467A)

-- \ -- <del>--</del>

複素環基のいずれかを示す。) 示す。) [化41]を繰り返し単位として有するポリフルオレン化合物、などが挙げられる。

【0048】また、これらのホスト剤を二種類以上併用することも可能である。このような併用は、例えば、電子輸送性を有する、[化2]乃至[化8]に示されオキサジアゾール系化合物や[化10]乃至[化15]及び[化38]乃至[化40]に示されるトリアゾール系化合物に対して、正孔輸送性を有する、[化20]乃至[化26]に示されるカルバゾール系化合物を併用したときに、発光領域の特定界面側への偏在を防止できるという効果がある。【0049】一方、発光層40のドープ剤41は、励起子たるホスト剤42の励起エネルギーにより燐光を放射する物質であり、

【0050】 【化42】



20 【0051】[化42]に示すトリ(2フェニルピリジン)イリジウム錯体(以下Ir(ppy)₃とも言う。)、

[0052]

【化43】



[0053]

【化44】

30



[0054]

【化45】



[0055]

【化46】



[0056]

【化47】





【0057】 【化48】



【0058】(化学式[化48]中、acacは、

[0059]

【化49】

【0060】[化49]で示される官能基を示す。下記 [化50]乃至[化54]に示す化学式において同じ。)

[0061]

【化50】



[0062]

【化51】



[0063]

【化52】



[0064]

【化53】



[0065]

【化54】



【0066】[化43]乃至[化48]、[化50]乃至[化54]で示されるイリジウム錯体化合物、 [化29] に示すPtOEP、などを挙げることができる。

【0067】また、発光層40に添加可能なバインダ高分子の例として、ポリスチレン、ポリビニルビフェニル、ポリビニルフェナントレン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルペリレン、ポリ (エチレン-co-ビニルアセテート)、ポリブタジエンのcisとtrans、ポリ(2-ビニルナフタレン)、ポリビニルピロリ

(8) 特開2003-7467A)

ドン、ポリスチレン、ポリ (メチルメタクリレート)、ポリ (ビニルアセテート)、ポリ (2-ビニルビリジンー co-スチレン)、ポリアセナフチレン、ポリ (アクリロニトリル-co-ブタジエン)、ポリ (ベンジルメタクリレート)、ポリ (ビニルトルエン)、ポリ (スチレン-co-アクリロニトリル)、ポリ (4-ビニルビフェニル)、ポリエチレングリコールなどが挙げられる。

【0068】また、正孔ブロック層50は、陽極層10 から発光層40へ注入された正孔がそのまま陰極層70 へ通過してしまうことを防ぐため正孔をブロックするための層であり、正孔ブロック性物質で構成される。正孔ブロック性物質としては、例えば、[化2]に示すPBD、[化3]に示すBND、[化4]に示されるBBD、[化5]に示すOXD-1、[化7]または[化8]に示すようなオキサジアゾール系高分子化合物、[化10]に示すTAZ、

[0069]

【化55】

20

30

50

【0070】[化55]に示すバソキュプロイン (以下B CPともいう。)、

[0071]

【化56】

【0072】 [化56] に示すトリス (8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム (以下Alq3ともいう。)、

[0073]

【化57】

【0074】[化57]に示す4,4<sup>7</sup>-ビス(1,1 40 -ジフェニルエテニル)ビフェニル(以下にDPVBi ともいう。)、

[0075]

【化58】

【0076】[化58]に示される4,4'-ビス



 $(1, 1- \forall Z, (4- \forall f) \forall Z )$  エテニル (以下DTVBiとも言う。)、

[0077]

【化59】

【0078】 【化60】

【0079】[化59]、[化60]で示すようなトリアゾール系高分子化合物、などを挙げることができる。 【0080】また、電子輸送層60は、陰極層70から 20 注入される電子を輸送するための層であり、電子輸送剤を含む。電子輸送剤は、電子輸送性高分子で構成され、さらに電子輸送性低分子を含む構成が可能である。

【0081】ここで、電子輸送性低分子の例として、 [化2] に示すPBD、[化3] に示すBND、「化 4] に示すBBD、[化5] に示すOXD-1、[化 6] に示すOXD-7、[化10] に示すTAZ、[化 11] に示す3,4,5-トリ(1-ナフチル)-1, 2, 4-トリアゾール、[化12] に示す3, 5-ジ (4-E) = (4-Eリアゾール、[化13]に示す4-(1-ナフチル)-3,5-ジフェニル-1,2,4-トリアゾール、[化 14] に示す1,3,5-トリ(5-(4-tert-ブチルフェニル) -1 - フェニル -1 , 3 , 4 - トリア ゾール) フェニル、 [化15] に示す1, 3-ジ(5- $(4-tert-\overline{\jmath}fh)-1-\overline{\jmath}fh$ 1,3,4-トリアゾール)フェニル、[化56]に示 すAlq3、[化57]に示すDPVBi、「化58] に示すDTVBiなどを挙げることができる。

【0082】また、電子輸送性高分子の例として、[化 40 7]、[化8]で示されるようなオキサジアゾール系高分子化合物、[化38]乃至[化40]及び[化59]、[化60]で示されるようなトリアゾール系高分子化合物、

[0083] 【化61】

(9) 特開2003-7467A) 16

【0084】(化学式[化61]中、Rはそれぞれ独立に 脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、エーテル基、複 素環基のいずれかを示す。)

[化 6 1]を繰り返し単位に有するポリフルオレン化合物、などが挙げられる。

【0085】発光効率のさらなる向上や構造の簡素化のため、図1に示す有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造に変更を加えたものとして、図2乃至図4に示す素子構造が可能である。

0 【0086】図2で示される有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構造は、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の第1の実施形態を示す。図1の電子ブロック層30と正孔ブロック層50とが省略されているが、図2において、正孔輸送層20に電子ブロック効果を、電子輸送層60に正孔ブロック効果をそれぞれ持たせて、発光効率を維持させることができる。

【0087】図3で示される有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構造は、図1で示す素子構造において、電子ブロック層30を省略したものである。

【0088】図4で示される有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構造は、図1で示す素子構造から、電子ブロック層30と正孔ブロック層50とを省略し、陰極層70と電子輸送層60との間に電子注入性物質で構成される電子注入層61を追加したものである。

【0089】電子注入性物質としては、たとえば、フッ化リチウム、酸化リチウム、

[0090]

【化62】

【0091】[化62]で示される8-ヒドロキシキノリナートリチウム(以下Liqともいう。) などが挙げられる。

【0092】次に、図2を本発明の第1の実施形態として、有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を説明する。

【0093】まず、基板(図示せず)となる透明絶縁性 支持体、例えばガラス基板上に陽極層10を蒸着法また はスパッタ法にて形成する。

【0094】次に、正孔輸送性高分子または正孔輸送性低分子を溶媒に溶解または分散した第1の溶液を作成する。ここで、第1の溶液に、さらにバインダ高分子を溶解または分散することも可能である。そして、第1の溶液を用いた湿式法によって、陽極層10上に正孔輸送層20を形成する。

【0095】さらに、発光層40のドープ剤41とホスト剤42とを溶媒に溶解または分散した第2の溶液を作成する。ここで、第2の溶液に、さらにバインダ高分子を溶解または分散することも可能である。そして、その

17

第2の溶液を用いた湿式法によって、上記正孔輸送層2 0上に発光層40を形成する。

【0096】さらに、電子輸送性高分子または電子輸送性低分子を溶媒に溶解または分散した第3の溶液を作成する。ここで、第3の溶液に、さらにバインダ高分子を溶解または分散することも可能である。その第3の溶液を用いた湿式法によって、発光層40上に電子輸送層60を形成する。

【0097】また、第2の溶液に用いた溶媒の溶解度パラメータは、発光層40の成膜温度において、正孔輸送 10層20に含まれる物質(正孔輸送性高分子または正孔輸送性低分子など)に対して可溶範囲外を示す値を有する。このような溶媒を用いた、湿式法による発光層40の形成において、下層の正孔輸送層20に含まれる有機物を溶解することがない。

【0098】また、第3の溶液に用いる溶媒の溶解度パラメータは、電子輸送層60の成膜温度において、発光層40に含まれる物質(ドープ剤41、ホスト剤42及びバインダ高分子など)に対して可溶範囲外を示す値を有する。このような溶媒を用いた、湿式法による電子輸20送層60の形成において、下層の発光層40に含まれる有機物を溶解することがない。

【0099】この時、上記の第1乃至第3の溶液に用いる溶媒は自然乾燥によって蒸発することにより、正孔輸送層20と発光層40と電子輸送層60とが形成される。この場合、加熱、紫外線の照射による重合、硬化等の処理を行う必要がなく、従って、製造工程が簡単であり、生産効率を向上させることができる。

【0100】本発明で使用される湿式法には、たとえばキャスティング法、プレードコート法、浸漬塗工法、ス 30ピンコート法、スプレイコート法、ロール塗工法、インクジェット塗工法などの通常の塗工法が含まれる。

【0101】最後に、電子輸送層60上に、蒸着法などを用いて陰極層70を形成し、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子が得られる。

【0102】なお、溶解度パラメータSPは、モル蒸発 熱 $\Delta$ H、モル体積Vの液体の絶対温度Tにおいて、

 $SP = \{ (\Delta H - RT) / V \}^{1/2}$ 

で定義される。ただし、上記式中、SPは溶解度パラメータ(単位: (cal/cm³) <sup>1/2</sup>) であり、ΔHはモ 40 ル蒸発熱(単位: cal/mol) であり、Rは気体定数(単位: cal/(mol·K)) であり、Tは絶対温度(単位: K) であり、Vはモル体積(単位: cm³/mol) である。

【0103】また、図3は、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の第2の実施形態であり、上記図2で示される素子構造の製造工程中、電子輸送層60の形成前に、発光層40上に[化2]に示すPBDなどの正孔ブロック性物質を湿式法により成膜して正孔ブロック層

50を形成した後に、該正孔ブロック層50上に、上記図2と同様に電子輸送層60と陰極層70とを順次形成する製造工程を経て得られる。

18

【0104】また、図4は、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の第3の実施形態であり、上記図2で示される素子構造の製造工程中、陰極層70の形成前に、電子輸送層60上に、フッ化リチウムなどの電子注入性物質を蒸着法により成膜して電子注入層61を形成した後に、該電子注入層61上に、上記図2と同様に陰極層70を形成する製造工程を経て得られる。

[0105]

【実施例】 [実施例1] 酸素プラズマ処理を行なった I T〇基板上(市販ΙΤΟ、旭硝子社製:20Ω/□以 下) に真空蒸着装置により真空度 1 0 - 3 P a で、正孔輸 送層として[化33]に示すNPDを蒸着速度1nm/s ecで60nmの膜厚で成膜し、発光層として[化5]に 示す O X D - 1 (イオン化ポテンシャル 6.1 e V、電 子親和力2.4eV)と[化24]に示すCBP(イオン 化ポテンシャル6.15eV、電子親和力2.33e V) と[化42]に示すIr (ppy) 3 (イオン化ポテ ンシャル5.3eV、電子親和力3.04eV)とを、 それぞれの重量比が1:1:0.03になるように蒸着 速度1nm/secで共蒸着し、20nmの膜厚で成膜 し、電子輸送層として[化56]に示すAla3を蒸着速 度1nm/secで50nmの膜厚で成膜し、最後に、 アルミニウムとリチウムとを、リチウムが1%となるよ うに蒸着速度1nm/secで共蒸着して陰極を形成し て、図2に示す素子構造を作成した。

【0106】この時、5V(駆動電圧、以下同じ)、1 mA/cm²(電流密度、以下おなじ)で500cd/m²(輝度、以下同じ)、 6.5V、10mA/cm²で4500cd/m²の緑色の発光を得た。

[実施例2]~[実施例5]OXD-1の替わりに下記[表1]に示す化合物を使用した以外は、[実施例1]と同様に図2に示す素子構造を作成したところ、[表1]に示す発光効率の発光が得られた。

[0107]

【表1】

20

実施例	実施例 化合物 1 m		1 m A / c m での性能		10m A / c ㎡での性能		電子親和力
- AED1	10 10 100	電圧 (V)	輝度(cd/m)	電圧 (V)	輝度(cd/㎡)	ポテンシャル (eV)	(eV)
_2	【化2】	5.0	500	6. 5	4, 500	6, 10	2.70
3	【化3】	4. 0	450	6. 0	3, 900	6. 10	3.05
4	(化4)	5. 0	500	6, 5	4, 500	6. 10	2. 90
5	(化6)	5. 2	500	7. 0	4, 300	6, 10	2, 70

【0108】[実施例3]でホスト剤として用いた[化3]で示すBNDは、電子親和力がドープ剤たるIr (ppy)。(3.04eV)とほぼ同等の為、ホスト剤からドープ剤へのエネルギー移動が効率良く行われない。このため、BNDと同じくオキサジアゾール基を持つ、[実施例1](OXD-1使用)、[実施例2](PBD使用)、[実施例4](BBD使用)、[実施例5](OXD-7使用)に比べ輝度が低い値になっている。効率の良い素子を作る為には、ドープ剤より小さい電子親和力を示すホスト剤が必要となる。また、同様に、イオン化ポテンシャルに付いても、ドープ剤より大きいイオン化ポ\*

\*テンシャルを示すホスト剤を選ぶと効率の良い素子が得られる。これは、上記のような電子輸送性のホスト剤だけでなく、正孔輸送性のホスト剤に付いても同様である。

のため、BNDと同じくオキサジアゾール基を持つ、 [実施例6]~ [実施例11] O X D - 1 の替わりに下記 [実施例1] (O X D - 1 使用)、[実施例2] (P B D 使 10 [表2]に示す化合物を使用した以外は、[実施例1]と同 用)、[実施例4] (B B D 使用)、[実施例5] (O X D 様に図2に示す素子構造を作成したところ、[表2] に - 7 使用)に比べ輝度が低い値になっている。効率の良 示す発光効率の発光が得られた。

[0109]

【表2】

実施例	化合物	1 m A / c m での性能		10m A / c	㎡での性能	イオン化	電子親和力
7,12,01		電圧 (V)	輝度(cd/ml)	電圧 (V)	輝度(cd/㎡)	ポテンシャル (eV)	(eV)
6	(化10)	5. 0	480	6. 5	4,000	5, 74	2, 18
7	(化11)	4. 0	480	6. 0	4,100	5. 80	2, 40
<u>       8                             </u>	(化12)	5. 0	480	6. 5	4, 100	5, 74	2, 30
9	(化13)	5. 2	480	7.0	4, 000	5, 80	2, 10
10	( <u>lt 1</u> 4)	5.0	480	6. 5	4, 100	5.74	2, 15
11	(化15)	5. 2	480	7.0	4.100	5.74	2 15

【0110】[実施例12]~[実施例15][実施例1] のCBPの替わりに下記[表3]に示す化合物を使用した 以外は、[実施例1]と同様に図2に示す素子構造を作成※ ※したところ、[表3]に示す発光効率の発光が得られた。

[0111]

【表3】

実施例	化合物	1 m A / c m での性能		10mA/cmでの性能		イオン化	電子親和力
7,1807	16 6 79)	<b>電圧 (V)</b>	輝度 (cd/㎡)	電圧 (V)	輝度(cd/m)	ポテンシャル (eV)	(eV)
12	【化20】	5.0	440	6. 5	4, 200	6, 05	2, 25
13	【化21】	5.0	460	6.5	4, 300	5, 96	2.17
14	[化22]	5. 0	470	6. 5	4, 300	5, 99	2, 52
15	[化23]	5. 0	490	6.5	4 400	6.05	2 21

【0112】[実施例16]~ [実施例27] [実施例1] で発光層ドープ剤のIr(ppy)₃に替え下記[表4] に化合物として示すドープ剤を使用した以外は[実施例

★4]に示す発光効率の発光が得られた。

[0113]

【表4】

1]と同様に図2に示す素子構造を作成したところ、[表★

実施例	化合物		っての性能	10m A / c i	mでの性能	発光ピーク波長
>< NE 71	16 12 120	電圧 (V)	輝度(cd/m)	電圧 (V)	輝度(cd/m)	(nm)
16	[化43]	5.0	450	6. 5	4, 200	545
17	(化44)	5.0	290	6. 5	2, 700	563
18	〔化45〕	5. 0	550	6. 5	5, 300	525
19	(化46)	5, 0	360	6. 5	3, 400	555
20	[化47]	4. 9	50	6. 5	480	608
21	(化48)	4. 9	510	6, 5	4, 500	516
22	(化50)	5. 0	450	6. 5	4, 300	545
23	(化51)	5. 0	280	6. 5	2, 500	563
24	(化52)	5.0	540	6. 5	5, 100	525
25	(化53)	5. 0	360	6. 4	3, 300	555
26	(化54)	4. 9	40	6. 4	380	608
27	(化29)	4. 9	15	6. 4	160	647

【0114】[実施例28]電子輸送層をAlq3に替 40 えOXD-1により形成した以外は[実施例1]と同様に図2に示す素子構造を作成した。この時、5.5V、1mA/cm²で500cd/m²及び、7V、10mA/cm²で4700cd/m²の緑色の発光が得られた。[実施例29]発光層と電子輸送層との間に正孔ブロック層として、真空度10<sup>-3</sup>Pa、蒸着速度0.1nm/secで真空蒸着により、[化55]に示すBCPを6nmの膜厚で成膜した以外は[実施例1]と同様に図3に示す素子構造を作成した。この時、5.2V、1mA/cm²で500cd/m²及び、6.7V、10mA/cm 50

40 °で4500cd/m°の緑色の発光が得られた。

[実施例30] [実施例1] で電子輸送層と陰極層との間に電子注入層として、真空度 $10^{-3}$  Pa、蒸着速度 0. 1 nm/sec条件の真空蒸着により、フッ化リチウムを5 nmの膜厚で成膜したことと、陰極をアルミニウムに替えたこと以外は[実施例1]と同様に図4に示す素子構造を作成した。この時、5 V、1 mA/cm²で5 00 cd/m²、及び6. 5 V、1 0 mA/c m²で4 50 0 cd/m²の緑色の発光が得られた。

す累子構造を作成した。この時、5.2V、1mA/c [実施例31] ゲルパーエイションクロマトグラフィー $m^2$ で $500cd/m^2$ 及び、6.7V、10mA/cm 50 により測定したポリスチレン換算重量平均量 (以下分子

量と言う。) 1, 100, 000の[化25]で示すPV K6mgを1mlの1,2ジクロロエタンで溶解して、 溶液 1 を作成した。酸素プラズマ処理を行なった ITO 基板上(市販ΙΤΟ、旭硝子社製:20Ω/口以下)に 溶液1を1000rpmで1秒間スピンコートする事に より50nmの膜厚の正孔輸送層を得た。正孔輸送層上 に真空蒸着装置により、真空度10<sup>-3</sup>Pa、蒸着速度1 nm/secでOXD-1とCBPとIr (ppy) 3 とを、それぞれの重量比が1:1:0.03になるよう 1nm/secでAlq3を蒸着し50nmの膜厚の電 子輸送層を成膜し、最後に、アルミニウムとリチウムと を、リチウムが1%となるように蒸着速度1nm/se cで共蒸着して陰極を形成して図2に示す素子構造を作 成した。この時、7V、1mA/cm<sup>2</sup>で500cd/ m<sup>2</sup>、及び8.3V、10mA/cm<sup>2</sup>で4500cd/ m<sup>2</sup>の緑色の発光を得た。

[実施例32]正孔輸送層の材料をPVKから[化31] で示す重合体(分子量60,000)に変えた以外は [実施例31]と同様に図2に示す素子構造を作成し た。この時、6V、1mA/cm<sup>2</sup>で500cd/m<sup>2</sup>及 び7.3V、10mA/cm<sup>2</sup>で4500cd/m<sup>2</sup>の緑. 色の発光が得られた。

[実施例33]分子量1,100,000のPVKとして 6 mgを1 mlの1,2ジクロロエタンで溶解して、溶\*

\*液1を作成した。OXD-1として1.25mgとCB Pとして1. 25mgとIr (ppy) 3として0. 1 7mgとバインダ高分子として分子量115,000の ポリビニルビフェニル2.5mgとをキシレン1mlに 溶解して、溶液2を作成した。酸素プラズマ処理を行な った I T O 基板上 (市販 I T O、旭硝子社製: 20Ω/ □以下) に溶液1を1000rpmで1秒間スピンコー トする事により50nmの正孔輸送層を得た。さらに、 正孔輸送層上に溶液2を1000rpmで1秒間スピン に共蒸着し20nmの膜厚の発光層を成膜し、蒸着速度 10 コートする事により20nmの発光層を得た。真空蒸着 装置により真空度10-3PaでAlq3を蒸着速度1n m/secで50nmの膜厚で電子輸送層を成膜し、最 後に、アルミニウムとリチウムとを、リチウムが1%と なるように蒸着速度1 nm/secで共蒸着して陰極を 形成して図2に示す素子構造を作成した。この時、9 V、1mA/cm<sup>2</sup>で480cd/m<sup>2</sup>、及び10.5 V、10mA/cm<sup>2</sup>で4500cd/m<sup>2</sup>の緑色の発光 が得られた。

> [実施例34]~ [実施例37] OXD-1の替わりに下 20 記[表5]に示す化合物を使用した以外は、[実施例33] と同様に図2に示す素子構造を作成したところ、「表5] に示す発光効率の発光が得られた。

[0115]

【表5】

実施例	化合物	1 m A / c ㎡での性能		10m A / c m での性能		イオン化	電子親和力
关心的	16 0 199	電圧 (V)	辉度(cd/mi)	電圧 (V)	輝度(cd/ml)	ポテンシャル (eV)	(eV)
34	【化2】	8.0	480	9, 5	4,500	6, 10	2.70
35	【化3】	8.0	430	10.0	3,700	6. 10	3. 05
36	[化4]	9.0	480	10.5	4,300	6.10	2.90
37	(化6)	9. 2	480	11.0	4, 100	6.10	2 70

【0116】[実施例38]~ [実施例43] OXD-1 30%ころ、[表6]に示す発光効率の発光が得られた。 の替わりに下記[表6]に示す化合物を使用した以外は、 [0117][実施例33]と同様に図2に示す素子構造を作成したと※ 【表6】

実施例 化合物		1mA/cmでの性能		10m A/c	mでの性能	イオン化 ポテンシャル	電子親和力
X4601	10 0 190	電圧 (V)	輝度 (cd/ml)	電圧 (V)	輝度(cd/m)	(eV)	(eV)
. 38	(化10)	9. 0	480	10. 5	4,000	5, 74	2. 18
39	(化11)	8.0	480	10.0	4, 100	5, 80	2, 40
40	【化12】	9.0	480	10. 5	4, 100	5. 74	2, 30
41	(化13)	9. 5	480	11. 0	4,000	5, 80	2. 10
42	【化14】	9.0	480	10. 5	4, 100	5. 74	2, 15
43	174 1 E T	10.0	700	11 0	4 100	E 74	0.15

【0118】 [実施例44] ~ [実施例47] CBPの ★ころ、[表7]に示す発光効率の発光が得られた。 替わりに下記[表7]に示す化合物を使用した以外は、 [0119][実施例33]と同様に図2に示す索子構造を作成したと★40

実施例	1 mA/cmでの性能		10m A / c ㎡での性能		イオン化	10000000000000000000000000000000000000	
90 MIN	16 6 40	電圧 (V)	輝度 (cd/ml)	電圧 (V)	好度 (cd/mi)	ポテンシャル (eV)	(eV)
44	(化20)	9.0	440	10.5	4, 200	6, 05	2, 25
45	(化21)	9, 0	460	10.5	4, 300	5, 96	2, 17
46	(化22)	9, 0	470	10.5	4, 300	5. 99	2, 52
47	(化23)	9.0	490	10.5	4 400	6.05	2 21

【0120】[実施例48]~ [実施例59]溶液2のⅠ r (ppy)₃の替りに下記[表8]に示す化合物を使用 した以外は[実施例33]と同様に図2に示す素子構造を 作成したところ、[表8]に示す発光効率の発光が得られ

た。

[0121]

【表8】



		•				LT
実施例	化合物		㎡での性能	10mA/c	mでの性能	発光ピーク波長
		電圧 (V)	輝度(cd/m)	電圧(V)	輝度(cd/m)	(nm)
48	(化43)	9. 0	450	10. 5	4, 200	545
49	(化44)	9. 0	290	10.5	2,700	563
50	(化45)	9. 0	550	10.5	5, 300	525
51	(化46)	9. 0	360	10. 5	3,400	555
52	(化47)	8. 5	50	10, 5	480	608
53	(化48)	8.5	510	10.5	4,500	516
54	(化50)	9. 0	450	10, 5	4,300	545
55	(化51)	9.0	280	10, 5	2,500	563
56	〔化52〕	9.0	540	10. 5	5, 100	525
57	(化53)	9. 0	360	10. 0	3, 300	555
58	〔化54〕	8. 4	40	10. 0	380	608
59	(化29)	8.4	15	10, 0	160	647

【0122】 [実施例60] 溶液2を、[化7]で示され BP2. 5mgとIr (ppy) ₃として0. 17mg とをキシレン1m1に溶解して作成した以外は [実施例 33]と同様に図2に示す素子構造を作成した。この 時、8V、1mA/cm2で480cd/m2 9V、1 0 mA/c m2で4500 c d/m2の緑色の発光が得ら れた。

[実施例61]溶液2を、[化7]で示される重合体の替 りに、[化8](分子量60,000)で示される重合体 を用いて作成した以外は [実施例60] と同様に図2に\*

\*示す素子構造を作成した。この時、8V、1mA/cm る重合体(分子量60,000)として2.5 mgとC 10 2で480 cd/m2及び、9V、10 mA/cm2で4 500cd/m²の緑色の発光が得られた。

> [実施例62]~[実施例64]溶液2を、[化7]で示 される重合体の替りに、下記[表9]に示す[化38]乃至 [化40](各分子量60,000)で示される重合体を 用いて作成した以外は[実施例60]と同様に図2に示 す素子構造を作成したところ、[表9]に示す発光効率の 発光が得られた。

[0123]

【表9】

実施例	化合物				mでの性能
	10 11 12	<b>■ 電圧 (∀)</b>	輝度(cd/m)	電圧 (V)	輝度(cd/mi)
62	[化38]	7. 0	450	8. 0	3, 800
63	(化39)	7. 0	450	8. 0	4, 000
64	[化40]	7. 0	450	8. 0	3, 900

【0124】 [実施例65] 溶液2を、 [化31] に示 すN-フェニルポリカルバゾール(分子量60,00 0) として2. 5mgとOXD-1として2. 5mgと Ir (ppy) ₃として0.17mgとをキシレン1m 1に溶解して作成した以外は[実施例33]と同様に図 2に示す素子構造を作成した。この時、7V、1mA/  $cm^2 \overline{c} 480 cd/m^2 8V$ ,  $10mA/cm^2 \overline{c} 4$ 500cd/m2の緑色の発光が得られた。

[実施例66] 分子量1,100,000PVK6m gを1m1の1,2ジクロロエタンで溶解して、溶液1 を作成した。OXD-1として1.25mgとCBPと UT1. 25mgとIr (ppy) ₃とUT0. 17m gとバインダ高分子として分子量100,000ポリ ビニルビフェニル2.5mgとをキシレン1mlに溶解 して、溶液2を作成した。PBDとして2.5mgとバ インダ高分子として分子量50,000のポリスチレン 2.5 m1とをシクロヘキサン1 m1に溶解して、溶液 40 3を作成した。

【0125】酸素プラズマ処理を行なったITO基板上 (市版ⅠT〇、旭硝子社製:20Ω/□以下)に溶液1 を、1000rpmで1秒スピンコートする事により5 0 nmの正孔輸送層を得た。正孔輸送層上に溶液2を、 1000rpmで1秒スピンコートする事により20n mの発光層を得た。さらに、発光層上に溶液3を、10 00rpmで1秒スピンコートする事により50nmの 電子輸送層を得た。

【0126】最後に、真空蒸着装置によりアルミニウム 50

とリチウムとを、リチウムが1%となるように蒸着速度 1nm/secで共蒸着して陰極を形成した。この時、 9.5V、1mA/cm<sup>2</sup>で480cd/m<sup>2</sup> 及び1 0.5V、10mA/cm<sup>2</sup>で4500 cd/m<sup>2</sup>の緑 色の発光が得られた。

[実施例67] 溶液2を、[化7]で示される重合体(分 子量60,000) 2.5mgとCBPとIr (pp y) 3として0.17mgとをキシレン1mlに溶解し て作成した以外は [実施例66] と同様に図2に示す素 子構造を作成した。この時、8.5V、1mA/cm<sup>2</sup> で480cd/m<sup>2</sup>及び、9V、10mA/cm<sup>2</sup>で45 00cd/m²の緑色の発光が得られた。

[実施例68] 溶液1を、PVKの替わりに[化31]で 示す重合体(分子量60,000)を用いて作成した以 外は[実施例67]と同様に図2に示す素子構造を作成 した。この時、8V、1mA/cm<sup>2</sup>で480cd/m<sup>2</sup> 及び9.0V、 $10mA/cm^2$ で $4500cd/m^2$ の 緑色の発光が得られた。

[実施例69]溶液3を、[化7]で示されるオキサジア ゾール系高分子化合物(分子量60,000)として5 mgをシクロヘキサン1mlに溶解して作成した以外は [実施例68]と同様に図2に示す索子構造を作成し た。この時、7V、1mA/cm<sup>2</sup>で460cd/m<sup>2</sup>及 び7.5V、10mA/cm²で4300cd/m²の緑 色の発光であった。

[0127]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明



(14) 特開2003-7467 (P2003-7467A)

【図2】本発明の素子構造の第1の実施形態 【図3】本発明の素子構造の第2の実施形態 【図4】本発明の素子構造の第3の実施形態

【符号の説明】

10 陽極層

40 発光層 41 ドープ剤

42 ホスト剤

70 陰極層

に用いる発光層のホスト剤は、バイポーラ性、即ち、即 ち、ラジカルカチオン化及びラジカルアニオン化し易い 複極性を有するので、発光層中で偏在せずにドープ剤を 励起して燐光の放射が可能になる。このように形成され た発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子で は、発光層中の発光領域が特定部分に集中せずに高輝度 の発光が得られる。

### 【図面の簡単な説明】

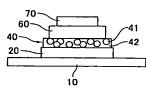
50 40~

30-

【図1】有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構造

【図1】





【図2】

【図3】



